

## Signalsensoren Ø5mm Metallfassungen

## Indicator Sensors Ø5mm Metal Holders

### Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 4

### General Remarks and Technical Data

General remarks and technical data: see page 4

### Spezifische Technische Daten

Gehäusewerkstoff: CuZn verchromt

Steckeinsatz: PC UL94 schwarz

Wellenlänge:  $\lambda$  950nm

Strahlstärke:  $I_e$  20mW/sr bei Durchlassstrom  $I_f$  100mA

Durchlaßspannung:  $V_f$  1.3V bei Durchlassstrom  $I_f$  100mA

Ausstiegszeit  $t_r$ , Abfallzeit  $t_l$ : 400ns

Halbwinkel:  $\varphi \pm 22^\circ\text{C}$

### Specific Technical Data

Housing Material: CuZn chrome plated

Plug Insert: PC UL94 black

Wavelength:  $\lambda$  950nm

Radiant Intensity:  $I_e$  20mW/sr at Forward current  $I_f$  100mA

Forward Voltage:  $V_f$  1.3V at Forward current  $I_f$  100mA

Rise time  $t_r$ , Fall time  $t_l$ : 400ns

Half angle:  $\varphi \pm 22^\circ\text{C}$

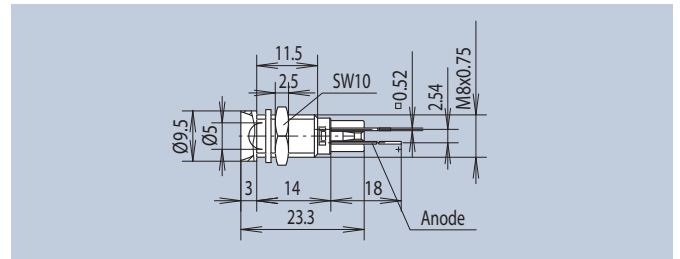
Die Infrarot-Dioden zeichnen sich durch gute spektrale Anpassung an Fototransistoren, hohe Strahlstärke und große Reichweite (6-10m) aus. Sie sind für Impulsbetrieb geeignet. Die Signalsensoren für Frontplatteneinbau sind für Schraubbefestigung mit einer empfohlenen Einbaubohrung von Ø8mm ausgelegt.

The infrared diodes are characterised by their good spectral adaptation to photo transistors, high beam intensity and long range distances (6-10m). They are suitable for pulsed operation. The signal sensors for front panel installation are designed for screw mounting with a recommended installation hole of Ø8mm.



Art.-Nr.

2690.8001



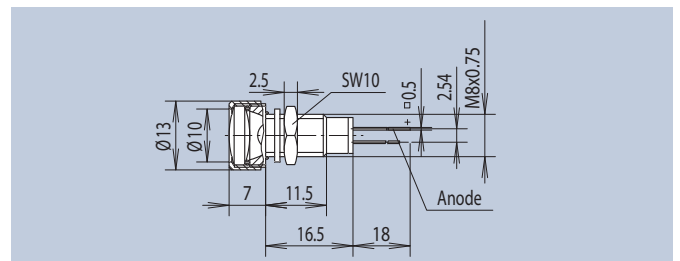
Durch Verwendung von Dichtungen ist die Infrarot-Diode in strahlwassergeschützter Ausführung IP65 einsetzbar. Lieferung inklusive Scheibe und Mutter.

Seals allow the infrared diode to be used in water-jet-proof IP65 designs. Supplied with washer and hexagonal nut.



Art.-Nr.

RTM 5070



### Spezifische Technische Daten

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung:  $V_{BR\ CE0}$  30V

Emitter-Kollektor-Durchbruchspannung:  $V_{BR\ ECO}$  5V

Verlustleistung:  $P_{tot}$  100mW

Anstiegszeit  $t_r$ , Abfallzeit  $t_f$ : 3 $\mu$ s

Wellenlänge:  $\lambda$  940nm

Kollektor-Emitter-Strom:  $I_{PCE}$  100 $\mu$ A

### Specific Technical Data

Collector-Emitter-Breakdown Voltage:  $V_{BR\ CE0}$  30V

Emitter-Collector- Breakdown Voltage:  $V_{BR\ ECO}$  5V

Power Disipation:  $P_{tot}$  100mW

Rise time  $t_r$ , Fall time  $t_f$ : 3 $\mu$ s

Wavelength:  $\lambda$  940nm

Kollektor-Emitter-Current:  $I_{PCE}$  100 $\mu$ A

Der Fototransistor zeichnet sich durch gute spektrale Anpassung an Infrarot-LED's aus. Er ist geeignet für Bereiche der sichtbaren und nahen infraroten Strahlung. Er besitzt eine hohe Fotoempfindlichkeit. Für Frontplatteneinbau mit Schraubbefestigung und einer empfohlenen Einbaubohrung von Ø8mm ausgelegt.

The photo transistor is characterised by its good spectral adaptation to infrared LEDs. It is suitable for visible and near-infrared radiation. It has a high photosensitivity. Designed for front panel installation with screw mounting and a recommended installation hole of Ø8mm.



Art.-Nr.

2691.8001

